

Содержание

• **Симпозиум „Нанофизика и Наноэлектроника“, Нижний Новгород, март 2013 г. (продолжение)**

Иконников А.В., Жолудев М.С., Гавриленко В.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.
Магнитопоглощение в узкозонных эпитаксиальных слоях HgCdTe в терагерцовом диапазоне 1569

Кукушкин С.А., Осипов А.В.
Анизотропия твердофазной эпитаксии карбида кремния на кремнии 1575

Юнин П.А., Дроздов Ю.Н., Дроздов М.Н., Королев С.А., Лобанов Д.Н.
Исследование многослойных полупроводниковых SiGe-структур методами рентгеновской дифрактометрии, малоугловой рефлектометрии и масс-спектрометрии вторичных ионов 1580

Германенко А.В., Миньков Г.М., Рут О.Э., Шерстобитов А.А., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н.
Двумерный полуметалл в широких квантовых ямах HgTe: энергетический спектр носителей и магнитотранспорт . . 1586

Витухновский А.Г., Ващенко А.А., Бычковский Д.Н., Дирин Д.Н., Тананаев П.Н., Вакштейн М.С., Коржонов Д.А.
Фото- и электролюминесценция полупроводниковых коллоидных квантовых точек в органических матрицах: QD-OLED 1591

Усикова А.А., Ильинская Н.Д., Матвеев Б.А., Шубина Т.В., Копьёв П.С.
Фотонные кристаллы и брэгговские решетки для излучателей среднего инфракрасного и терагерцового диапазонов спектра 1595

Паневин В.Ю., Софронов А.Н., Воробьев Л.Е., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А., Винниченко М.Я., Балагула Р.М., Тонких А.А., Werner P., Fuhrman V., Schmidt G.
Латеральная фотопроводимость структур с квантовыми точками Ge/Si 1599

Курова Н.В., Бурдов В.А.
Первопринципные расчеты электронной структуры кремневых нанокристаллов с мелкими донорами (Li, P) . . . 1604

Волкова Н.С., Горшков А.П., Здоровейщев А.В., Вихрова О.В., Звонков Б.Н.
Оптоэлектронные свойства гетеронаноструктур с комбинированными слоями квантовых ям и точек In(Ga)As/GaAs 1609

Бобров А.И., Павлова Е.Д., Кудрин А.В., Малехонова Н.В.
Исследования структуры ферромагнитного слоя GaMnSb 1613

Павлова Е.Д., Горшков А.П., Бобров А.И., Малехонова Н.В., Звонков Б.Н.
Исследование гетероструктур с комбинированным слоем квантовых точек/квантовой ямы In(Ga)As/GaAs и δ -слоем Mn 1617

Кривулин Н.О., Павлов Д.А., Шиляев П.А.
Модель роста наноостровков кремния на сапфире 1621

Ларионов А.В., Ильин А.И.
Латерально локализуемый потенциал как инструмент для управления временем спиновой релаксации электронов в квантовых ямах GaAs 1624

Белоусов Ю.М., Соловьев В.Р., Черноусов И.В.
Использование квазиупругого и неупругого приближений для описания динамики носителей заряда в алмазе 1630

• **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Khan Majid, Islam Mohammad
Deposition and characterization of molybdenum thin films using DC-plasma magnetron sputtering 1636

• **Спектроскопия, взаимодействие с излучениями**

Гук И.В., Марциновский Г.А., Шандыбина Г.Д., Яковлев Е.Б.
Моделирование поглощения фемтосекундного лазерного импульса кристаллическим кремнием 1642

• **Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**

Супрядкина И.А., Абгарян К.К., Бажанов Д.И., Мутигуллин И.В.
Исследование поляризаций нитридных соединений (Al,Ga,AlGa)N и зарядовой плотности различных интерфейсов на их основе 1647

• **Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

Покутный С.И.
Биэкситон из пространственно разделенных электронов и дырок в полупроводниковых квазиультимерных наносистемах 1653

Божинова А.С., Канева Н.В., Кононова И.Е., Налимова С.С., Сюлейман Ш.А., Папазова К.И., Димитров Д.Ц., Мошников В.А., Теруков Е.И.
Изучение фотокаталитических и сенсорных свойств наноккомпозитных слоев ZnO/SiO₂ 1662

Чуенков В.А.

Динамические характеристики двухбарьерных наноструктур с несимметричными барьерами конечной высоты и ширины в сильном переменном электрическом поле 1667

● **Физика полупроводниковых приборов**

Калиновский В.С., Лёвин Р.В., Пушный Б.В., Мизеров М.Н., Румянцев В.Д., Андреев В.М.

Получение и исследование $p-n$ -структур с кристаллическими включениями в области пространственного заряда 1677

Зубов Ф.И., Шерняков Ю.М., Максимов М.В., Жуков А.Е., Лившиц Д.А., Паюсов А.С., Надточий А.М., Савельев А.В., Крыжановская Н.В., Гордеев Н.Ю.

Спектральная зависимость фактора уширения линии в лазерах на квантовых точках 1681

● **Персоналии**

Александр Александрович Орликовский

(к 75-летию со дня рождения) 1687